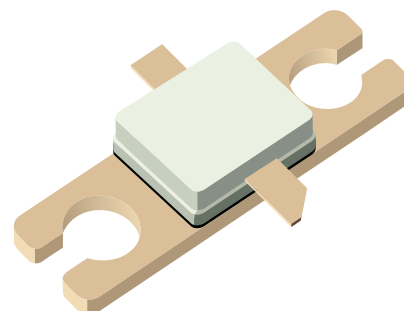


Мощный СВЧ GaN транзистор с напряжением питания 28 В  
 Герметизирован в металлокерамическом корпусе КТ-81С  
 Предназначен для работы в усилителях мощности до 6000 МГц

- Выходная мощность  $P_{\text{вых}} = 15$  Вт
- Напряжение питания  $U_{\text{си}} = 28$  В
- Коэффициент усиления по мощности  $K_{\text{ур}} \geq 11,0$  дБ
- КПД стока  $\eta_c \geq 50$  %



### Предельно допустимые значения электрических режимов эксплуатации

Максимально допустимый постоянный ток стока	$I_c$ макс	2,0	А
Максимально допустимый прямой ток затвора	$I_z$ (пр) макс	6,0	мА
Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток	$U_{\text{си макс}}$	130	В
Напряжение затвор-исток	$U_{\text{зи}}$	-10 до +2	В
Максимально допустимая температура перехода	$t_{\text{п макс}}$	225	°С
Диапазон рабочих температур		-60 до +125	°С
Тепловое сопротивление переход-корпус транзистора	$R_{\text{т п-к}}$	5,0	°С/Вт

### Электрические параметры транзисторов

Параметр	Обозначение	Режим измерения	Не менее	Тип.	Не более	Единица измерения	Температура среды (корпуса), °С
Остаточный ток стока	$I_c$ ост	$U_{\text{си}}=80$ В; $U_{\text{зи}}=-8$ В	-	-	2,0	мА	25±10
Крутизна характеристики	S	$U_{\text{си}}=10$ В; $I_c=1,2$ А	1,0	1,3	-	А/В	25±10
Ток стока насыщения	$I_c$ нас	$U_{\text{си}}=6$ В; $U_{\text{зи}}=2$ В	4,4	4,8	-	А	25±10
Выходная мощность	$P_{\text{вых}}$	$f=4000$ МГц; $U_{\text{си}}=28$ В $P_{\text{вых}}=1,2$ Вт $I_c=0,1$ А	15	20	-	Вт	(25±15)
Коэффициент усиления по мощности	$K_{\text{ур}}$	$f=4000$ МГц; $U_{\text{си}}=28$ В; $P_{\text{вых}}=15$ Вт $I_c=0,1$ А	11,0	13,0	-	дБ	(25±15)
КПД стока	$\eta_c$	$f=4000$ МГц; $U_{\text{си}}=28$ В; $P_{\text{вых}}=15$ Вт; $I_c=0,1$ А	50	55	-	%	(25±15)

Габаритный чертеж

